

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ К311

Общие данные

Микросхемы интегральные серии К311 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии К311

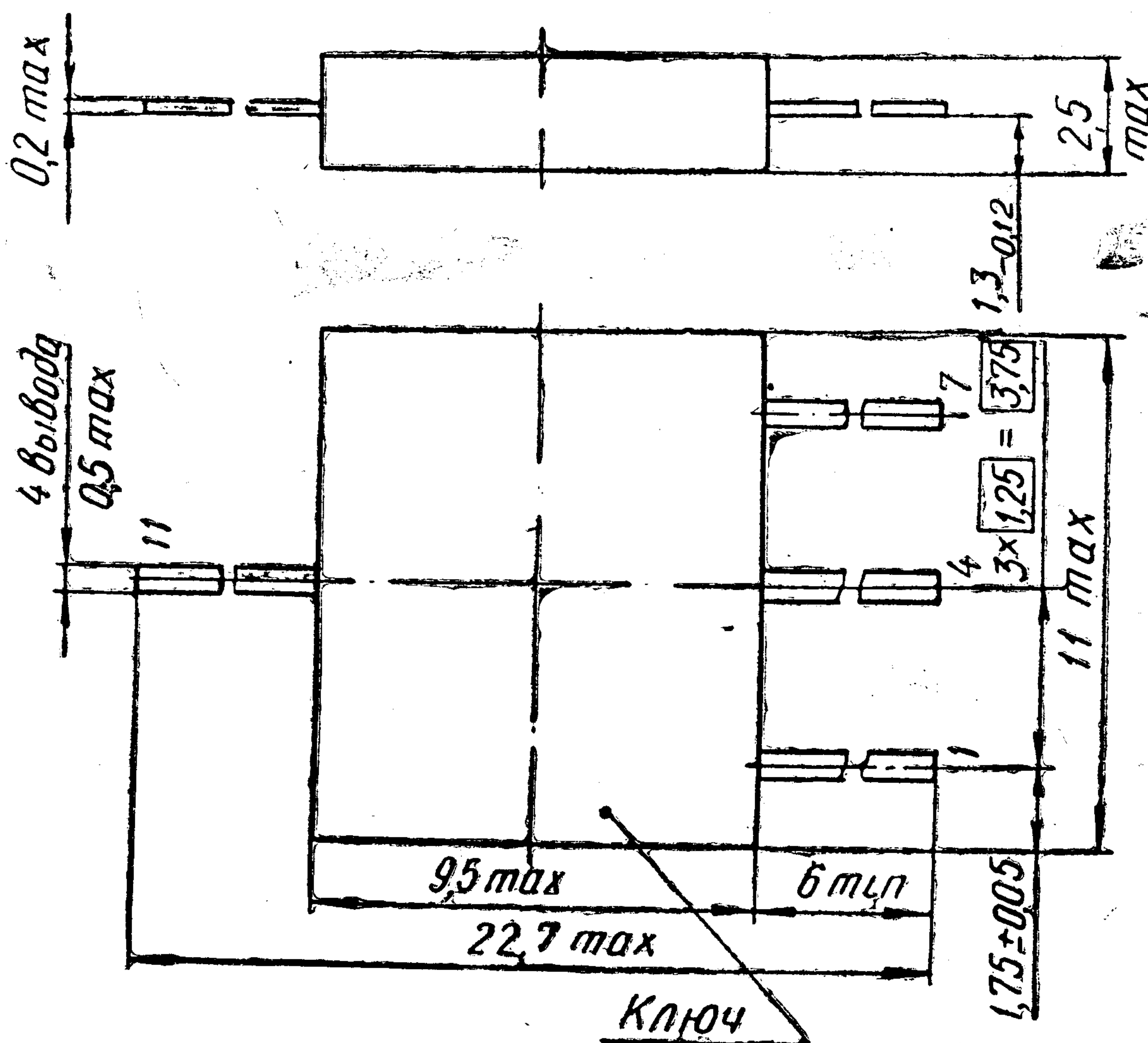
Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Обозначение документа на поставку
К311НР101— К311НР131 К311НР201— К311НР231 К311НР301— К311НР331	Набор резисторов (согласование уровня сигналов по напряжению)	6К0.348.420 ТУ

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ К311

Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольном пластмассовом корпусе 402.4-1.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 1 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 2000
амплитуда ускорения, м/с ² (g)	200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, м/с² (g) 5000 (500) |

Пониженная рабочая температура среды, °С минус 45 |

Повышенная рабочая температура среды, °С 85 |

Изменение температуры среды, °С от минус 45 до +85 |

Относительная влажность воздуха при 40°С, % 95±3 |

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ К311

Общие данные

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка *, ч	25 000
Срок сохраняемости *, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом пайки и паяльником. Микросхемы устанавливают на платы вплотную приклеивкой.

Допускается кратковременная не более 0,5 ч 1,5-кратная или не более 0,25 ч 2-кратная перегрузка по входной мощности с сохранением точностных характеристик после снятия перегрузки.

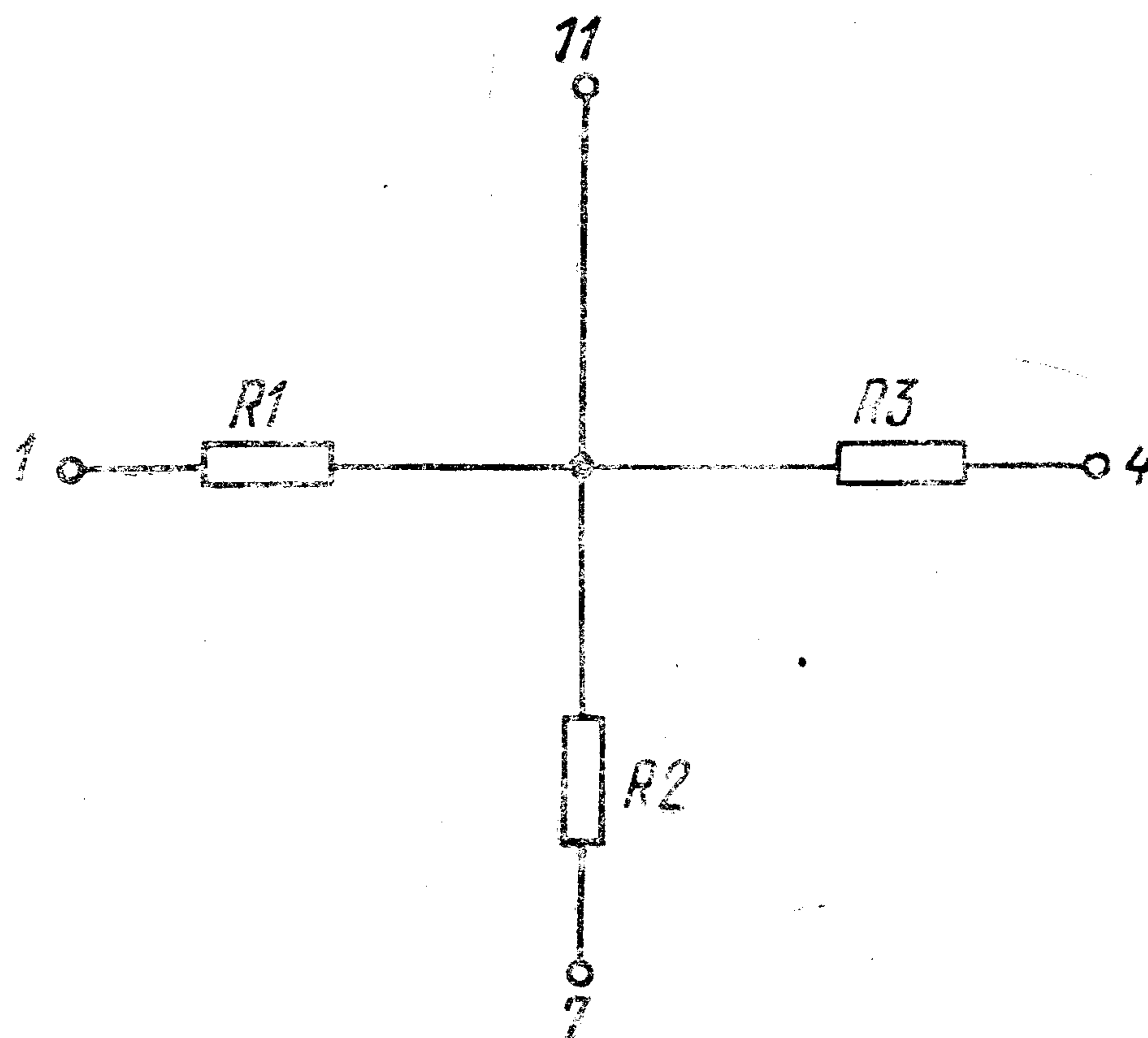
Допускается обрезка незадействованных в электрической схеме аппаратуры выводов способом, не нарушающим целостность корпуса микросхемы.

Допускается эксплуатация микросхем в условиях воздействия вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц при ускорении до 40 g.

Допускается располагать микросхемы при монтаже в вертикальном положении. Микросхемы после установки их на платы рекомендуется покрывать влагозащитным лаком. Количество слоев — 3.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Погрешность затухания, дБ, не более:

К311НР101—К311НР106, К311НР201—К311НР206, К311НР301—К311НР306	±0,025
К311НР107—К311НР114, К311НР207—К311НР214, К311НР307—К311НР314	±0,04
К311НР115—К311НР120, К311НР215—К311НР220, К311НР315—К311НР320, К311НР121—К311НР126, К311НР221—К311НР226, К311НР321—К311НР326 К311НР127—К311НР131, К311НР227—К311НР231, К311НР327—К311НР331	±0,060 ±0,075 ±0,1
Погрешность входного сопротивления, %, не более	±1
Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее	100

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Величина постоянного или действующего переменного напряжения, подаваемого на контакты 1—4 микросхемы, В:

К311НР101	7,0
---------------------	-----

К311НР101—К311НР131
К311НР201—К311НР231
К311НР301—К311НР331

НАБОР РЕЗИСТОРОВ (СОГЛАСОВАНИЕ
УРОВНЯ СИГНАЛОВ ПО НАПРЯЖЕНИЮ)

К311НР102	5,0
К311НР103	4,0
К311НР104	3,5
К311НР105—К311НР108	3,0
К311НР109—К311НР111	2,4
К311НР112—К311НР131	2,0
К311НР201	10
К311НР202	7,0
К311НР203	5,5
К311НР204	4,9
К311НР205—К311НР208	4,0
К311НР209—К311НР211	3,5
К311НР212—К311НР231	2,8
К311НР301	20,0
К311НР302	14,0
К311НР303	11,0
К311НР304	9,8
К311НР305—К311НР308	8,0
К311НР309—К311НР311	7,0
К311НР312—К311НР331	5,5